
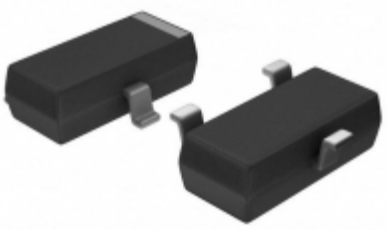








	<p>SI2303CDS-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2303CDS-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 2.7A SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  SI2303CDS-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 85977 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2303CDS-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 2.7A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	85977 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 2.7A (Tc) 2.3W (Tc) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	2.3W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 1.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	155pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2303CDS-T1-E3CT

SI2303CDS-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI2303CDS-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2303CDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2303CDS-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2303BDS/A5 VISHAY SI2303BDS/A5 VISHAY</p>	 <p>SI2303BDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23-3</p>	 <p>SI2303CDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 2.7A SOT23-3</p>	 <p>SI2303BDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23-3</p>
 <p>SI2303CDS-TI-GE3 VISHAY VISHAY SOT23</p>	 <p>SI2303CDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 2.7A SOT23-3</p>	 <p>SI2303CDS-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 2.7A SOT23-3</p>	 <p>SI2303DS VISHAY SI2303DS VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

SI2302BDS-T1-E3	SI2302CDS-T1-E3	SI2302CDS-T1-E3	SI2302CDS-T1-GE3	SI2302CDS-T1-GE3
SI2302DDS-T1-GE3	SI2302DDS-T1-GE3	SI2302DS	SI2302DS-ES	SI2302DS-T1
SI2302DS-T1-E3	SI2302DS-T1-GE3	SI2302DV	SI2302WCB	SI2303ADS-T1-GE3
SI2303BDS	SI2303BDS-T	SI2303BDS-T1	SI2303BDS-T1	SI2303BDS-T1-E3
SI2303BDS-T1-E3	SI2303BDS-T1-GE3	SI2303BDS-T1-GE3	SI2303BDS/A5	SI2303CDS
SI2303CDS-T1-E3	SI2303CDS-T1-GE3	SI2303CDS-T1-GE3	SI2303DL-T1-E3	SI2303DS
SI2303DS-T1	SI2303DS-T1-E3	SI2303DS-T1-GE3	SI2304-TP	SI2304BDS-T1-E3
SI2304BDS-T1-E3	SI2304BDS-T1-GE3	SI2304BDS-T1-GE3	SI2304BDS-TI-E3	SI2304DDS-T1-E3
SI2304DDS-T1-GE3	SI2304DDS-T1-GE3	SI2304DS	SI2304DS-T1	SI2304DS-T1-E3
SI2304DS-T1-GE3	SI2305-CDS-T1-GE3	SI2305ADS-T1-E3	SI2305ADS-T1-E3	SI2305ADS-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited